◎ 公開特許公報(A) 平2-96919

®Int. Cl. 5

ッ

識別記号

庁内整理番号

④公開 平成2年(1990)4月9日

G 11 B 5/66 5/704 7350-5D 7350-5D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

國発明の名称 磁気記録媒体

②特 願 昭63-249284

@出 願 昭63(1988)10月3日

⑩発明者 山口 希世登 神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会

社内

⑩発 明 者 大久保 恵 司 神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会

社内

⑩発 明 者 山 崎 恒 神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会

社内

⑪出 顋 人 富士電機株式会社

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

四代 理 人 弁理士 山口 巖

明 細 響

1. 発明の名称 磁気記録媒体

2. 特許請求の範囲

1) ブラスチックまたはブラスチックとセラミックの複合材料からなる基板上に圧縮応力をもつ Si₁N₄ 膜とを交互に積み重ねたパッファ層、非磁性金属下地層、磁性層および保護網滑層をこの順に形成してなることを特徴とする磁気配録媒体。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は磁気記録装置に用いられる磁気ディスクなどの磁気記録媒体に関する。

〔従来の技術〕

第3図は従来用いられている磁気記録媒体の模式的な要部構成断面図を示したものである。第3図の磁気記録媒体はA&-Mg 合金基板1の上に非磁性金属基体層2を被優し、この非磁性金属基体層2上にさらに非磁性金属下地層3を介して例えばCo-Ni-Cr 合金導膜の磁性層4を被優し、磁

性層 4 上に保護調滑層 5 を設けてあり、基板 1 に 非磁性金属基体層 2 から保護機滑層 5 までをこの 符号順に積み重ねたように構成したものである。

このように構成された磁気配録媒体は製造過程で基板1を所定の面相さ、平行度および平面度に仕上げ、非磁性金属基体層2はNiーP合金を処理解めっきもしくは基板1自体をアルマイトのではあることにより形成するのが好ましく、いずれものでの硬さを必要とし、表面は機械的研磨を行って所定の面積度まで仕上げる。非磁性金属下のでである。などの保護調剤圏5を連続的にスパッタして被優する。

して形成したものの代表的な磁気特性として保証 カ Hc は 900 Oe でである。

以上のような田気配録媒体は路等性の向上とと もに近年ますます軽量化とコストの低級に対する 要求が高められている。

(発明が解決しようとする課題)

配鉄鉄体の軽慢化とコスト低酸に対して考慮すべき点は基板材料の選択である。すなわち、A&-Mg 合金を基板に用いているために、この上に硬いNi-P Mを設けねばならず、基板面とNi-P Mの装面研磨加工に多大の時間を要し、このことがコストに大きな比率を占めている。したがって、この加工工数を短縮するためには、所定の面相さ、平行度および平面度に仕上げなければならないので、大幅な工数省略は不可能であってコストの低級には限界があり、A&-Mg 合金を用いる限り多くを期待することができない。

一方差板材料の選択に関しては記録媒体の駆動 化も含めて、ブラスチックもしくはブラスチック とセラミックの複合材料を用いるのが有望である。

ることができる構造を有する磁気配像媒体を提供 することにある。

〔躁焰を解決するための手段〕

本発明の磁気記録媒体はブラスチックなどの非磁性基板上に、圧縮応力をもつ Si₁N₄ 膜と引張応力をもつ Si₂N₄ 膜とを交互に積み重ねたパッファ 温・非磁性金属下地層・磁性層および保護調慮を この順にスパック形成したものである。

(作用)

無膨緩係数の大きいプラスチック基板(約23 × 10⁻¹/で)とこれよりかなり 無能接係数の小さいの無疑(Cr:約8.4 × 10⁻¹/で)との間に成原時の無限性(昇進と降進)によって生ずる内部に力を吸収または緩和させるために、パッファ層を設けてある。このパッファ層を設けて形成すると例えば少なくとも 1000 Å 程度の厚めるのがあるとする。しかしパッファ層の厚さは必要とするにより大きくすることはできない所定の厚さ内にパッファ層を収めるとき、単一材料を用いてただ一層としたのではその中を応力が伝播す

これらの材料は A.e-Mg 合金より 軽く、金型を用いて成形することができるので、金型の袋面を高精度に加工しておくことにより、成形後の袋面研磨を行なうことなく十分に良好な 面粗さや平行度が得られるという利点があるからである。

しかしながら、基板としてブラスチックまたは その複合材を用いるときは、別な問題が超きる、 それは、ブラスチックと金属の熱彫張係数にした。 を差があるためブラスチック基板上に成膜にクラックが発生しやすい点である。 ラックは、その大きさおよびな量により、確ひを 耐食性低下や 田気配録に見のエラー増加を 全のの はです 原因となる。したがって、 Ae-Mg 合金に保 りブラスチックなどを基板に用いたときも配録は 体の信頼性を損なわないようにする必要がある。

本発明は上述の点に進みてなされたものであり、 その目的は磁気記録媒体をより軽量とし、コスト を低減するためにプラスチックまたはプラスチッ クとセラミックの複合材料を用い、しかも良好な 磁気特性を有し、金属膜のクラック発生を防止す

るだけで応力を吸収または緩和する役割を果たす ことができない。

そこで本発明のようにパッファ層を同種の形態 の異なる膜を多層に積み重ねたものとして形成し、 応力伝播を避らせ、それぞれの膜の界面において 応力緩和を分担させることにより、全体の応力緩 和に寄与させることが可能となる。しかもこれら の膜は磁気記録媒体の製造工程上、成膜が容易で あることに加えて、成膜時の条件散定によって形 態の異なる同様の膜を交互に積層できるものでな ければならない。このようなことから、パッファ 層としては圧縮応力をもつ SiaNa 膜と引張応力を もつ SiaNa 膜との組み合わせは両者の密滑性。略 合性の点からも好通であり、これらを交互に積層 すると、パッファ層全体として所定の厚さの中に 形限の異なる同種の膜が一つ資きに積み重ねられ たものとなり、このパッファ層がプラスチック共 板と金属膜との熱膨張係数の大きな差によって生 ずる内部応力を緩和し、金属膜のクラック発生を 防止するように作用する。

〔寒 施 例〕

以下本発明を実施例に基づき説明する。

第1図は本発明により得られた磁気記録媒体の 模式的な要部構成断面図を示したものであり、 第 3図と共通部分を同一符号で扱わしてある。 第1 図は第3図と基本的な構成は同じであるが、 第1 図が第3図と異なる点は基板1a に ブラスチック を用い、 基板1a と非 田性 金 属下 地層 3 との間に、 非 田性 金 属 基 体 層 2 ではなく、 パッファ 層 6 が介 在 するように構成したことにある。

この 田気記録 媒体はまず 基板材料にポリェーテルイミド 樹脂の 商品名 ウルテム 1000 を用い、所定の 表面 特度をもった 金型により成形して 基板 1a を作製し、この 基板 1a 上に 圧縮 応力をもつ Si_1N_4 膜($2\sim5\times10^6$ dyn/d) 6a と 引張 応力をもつ Si_1N_4 膜($-1\sim-4\times10^9$ dyn/d) 6b を 交互に 積度して なる パッファ 層 6 を 形成するが、 第1 図では 便宜上 これら 薄膜の 積層 数を 6 層とした 場合で示して あり、 圧縮 応力をもつ Si_1N_4 膜 6a と引張 応力をもつ Si_1N_4 膜 6a と引張 応力をもっ Si_1N_4 膜 6a と

さらにパッファ層 6上に順次形成する非磁性金属下地層 3 の Cr , 磁性層 4 の Co - Ni - Cr 合金および保護網滑層 5 のカーボンの成蹊をいずれもDCスパッタ法により次の条件により行なう。

燕板温度:80℃以下

原 料: Crターゲット, Co-Ni-Cr合金ター ゲット, Cターゲット, Arガス

成膜圧力: 10 m Torr

ここで圧縮に力をもつ Si₁N₄ 膜 6 a と引張に力をもつ Si₂N₄ 膜 6 b は次のようにして形成される。すなわち、同一反応槽内で E C R ブラズマ C V D と D C スパッタとが可能な装置により、 E C R ブラズマ C V D 法を用いて、基板温度 80 で以下とし、原料の Si H₄ , N₂ ガスを導入して成膜圧力は 0.5~5 mTor・の範囲で変化させる。このとき成膜圧力が 1 mTorr 以下で圧縮応力をもつ Si₂N₄ 膜 6 a が形成され、成膜圧力を1 mTorr 以上にすると引張応力をもった Si₂N₄ 膜 6 b を形成することができる。この成膜圧力の変化を繰り返し行ない、膜6 a と膜 6 b がそれぞれ 50 Åの厚 さとなるように交互に成膜機層することによりパッファ 層 6 が待られる。

次に以上のごとくして得られたそれぞれの磁気 記録媒体について金属膜に発生するクラック数と 耐食性能について比較を行ない、その結果を餌2 図(a),(b)に示す。 第2図(a)は 縦軸を非磁性金属下 地層 3 の Cr に発生する単位面段(mi)あたりの 1 #m以上のクラック数とし、横軸をパッファ層 6 内に交互に積み重ねるように成膜した圧縮応力を もつ Si, N. 膜 6 a と引張応力をもつ Si, N. 膜 6 b との積層数とし、それぞれの磁気配象媒体につい て10点御定した平均値をブロットしたものである。 第2図(b)は、縦軸を媒体の代表的な磁気特性であ る残留磁束密度Brと、磁性層4の膜厚4の積値 Br・8 について、80℃, 80 % R H 環境内に放戦し た1ヶ月耐食性試験後の彼少率ムBr・8とし、機 軸は第2図(a)と同様膜 6 a と膜 6 b の積温数を表 わし、ブロットは同じく10点行なって平均値を用 いた。

第2図(a),(b)ともに、本発明によるパッファ lb 6を形成するのにブラスチック基板を用いたもの (o),同じくブラスチック複合材の基板を用いた もの (①) ,比較のためのプラスチック基板を用いた圧縮応力をもつ Si_3N_4 膜 6a 単独のもの (Δ) および引張応力をもつ Si_3N_4 膜 6b 単独のもの (X) を併配してある。

第2図(a),(b)の両図を参照すればわかるように、パッファ暦 6 が単一材料の一層のみでは膜 6 a, 膜 6 b のいずれの場合も、 Cr 下地層 3 に80 個以上のクラックが発生し、それが原因となって ΔBr・δ 値は 5 %以上に達する。 このことは単一材料の場合この実施例の範囲で 膜厚を変化させても同じである。 ΔBr・δ 値が 5 %以上になると 断気配象 媒体の記録, 再生の繰り返しによるエラーが増加するので、パッファ 層 6 としては単一材料のみで形成するのが 延当でないことは 明らかである。

これに対して、圧縮応力をもつ Si_3N_4 膜 6a と 圧縮応力をもつ Si_3N_4 膜 6b とを交互に 程 層 0 た 0 の

基板1aと非既性金属下地層3のCrとの大きな 無膨張係数の相違に起因して生ずる内部応力を膜 6aと膜6bがそれぞれの界面で吸収または緩和 するように働き、その結果金属下地層3のCrに クラックが発生するのを防止することができる。

また本発明の磁気記録媒体を磁気記録装置に組み込んでCSS試験を行なった結果、2万回のコンタクト・スタート・ストップに対しても、この 媒体装画にはなんら毎の発生は見られず、再生出 力もほとんど低下することなく、十分な耐久性を もっていることを確認することができた。

そのほか本発明の磁気記録媒体は基板にブラスチックまたはその複合材料を用いているために、 従来の All - Mg 合金基板より約60 %軽量になると ともに、複雑な研磨工程を必要とせず、基板上に 堆級させる各層は本発明に係るパッファ層も含め で同一反応槽内で順次形成させればよいという利 点もある。

〔発明の効果〕

衄気紀録媒体は軽量にするとともに、コストの

第3図に示した従来の A.8 合金基板 1 に Ni ー P めっきの非磁性金属下地層 2 を被覆した磁気配録 は体における ABr・8 値 1.5 % ~ 2 % とほぼ 同等の値が得られる。また同時に作製したポリエステル樹脂と炭酸カルシウムとの複合材料を基板とする磁気配録 媒体も、ポリエーテルイミド樹脂の基板を用いたものと同様の効果があることを第2図(a),(b)から確認することができる。

圧縮に力をもつ Si a N 4 膜 6 a や引張応力をもつ Si a N 4 膜 6 a や引張応力をもつ Si a N 4 膜 6 b を単独にバッファ暦 6 として用いるときは、その膜厚は 1000 Å 以上を必要とすると 考えられるが、本発明では圧縮応力をもつ Si a N 4 膜 6 b との積層体としてバッファ 6 6 を形成したために、膜 6 a と膜 6 b の厚さがいずれも 50 Å であるから、10 層重ねたとしても、バッファ層 6 の膜厚は 500 Å で足りることになる。

以上のように圧縮応力をもつ SiaNa 與 6 a と引 張応力をもつ SiaNa 膜 6 b を交互に 横層形成した パッファ層 6 を有する本発明の磁気配鉄媒体は、

低減が望まれており、加工工数の多い従来のA& 合金基板に代って、後加工なしで高い炭面精度の 得られるブラスチックまたはその複合材料を用い ることができるが、これらプラスチック系材料の 基板は、その上に形成される金属膜(Cr)と熟能 張係数が大きく異なるため、成膜後の金属膜にク **ラックを発生し、このことが原因となって媒体の** 耐食性能が著しく低下する。これに対して本発明 の磁気記録媒体は実施例で述べたように、ブラス チック系基板と金属膜との間に、成膜圧力を変化 させることにより形成される圧縮応力をもつSi, Na 膜と引張応力をもつ Si₃N₄ 膜とを交互に積み重ね たパッファ届を介在させるようにしたため、店板 と金属膜の私膨張係数の差により生ずる内部応力 を、積層されたそれぞれの膜の界面で吸収または 緩和するように分担することが可能となり、これ が単一材料のバッファ層では不可能であった500 。 A.以下の與厚のパッファ層で応力緩和を実現させ、 その結果金属膜にクラックが発生するのを防ぐこ とができる。

以上のことから、本発明の磁気配録媒体はTルミニウム系基板を用いたときに起きる本質的な欠点を排除し、従来の A.O 合金基板を用いた媒体と同様の耐食性能および信頼性を維持するものである。

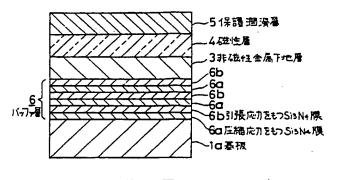
4.図面の簡単な説明

第1図は本発明の磁気配録媒体の要部構成を示す模式断面図、第2図回は本発明の磁気記録媒体のパッファ層内の積層数と非磁性金属下地層に生するクラック数との関係線図、第2図的は同じくパッファ層内の積層数とABr・8との関係線図、第3図は従来の磁気記録媒体の要部構成を示す模式断面図である。

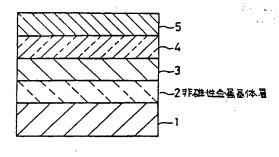
1,1a ··· 基板、2 ··· 非田性金属基体層、3 ··· 非田性金属下地層、4 ··· 田性層、5 ··· 保護陶滑層、6 ··· パッファ層、6 a ··· 圧縮応力をもつ Si₂ N₄ 膜、6 b ··· 引張応力をもつ Si₂ N₄ 膜。

代理人并理士 山 口 着





第1図



第 3 図

